

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-297227

(43)Date of publication of application : 10.11.1995

(51)Int.Cl.

H01L 21/60

(21)Application number : 06-088762

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing : 26.04.1994

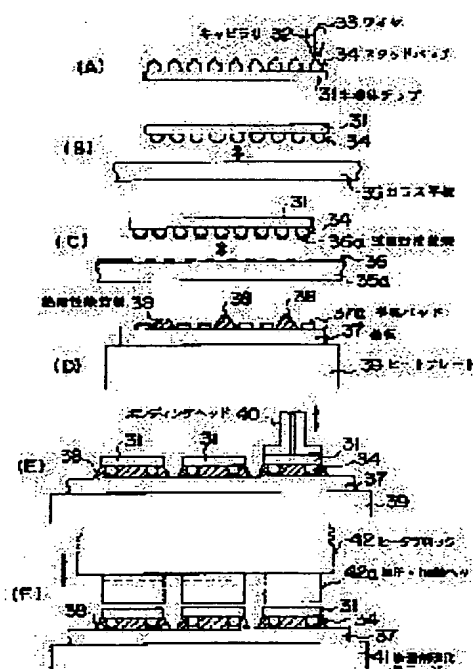
(72)Inventor : KIRA HIDEHIKO
FUJII MASANAO
ISHIKAWA NAOKI

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To perform complete flip chip bonding while reducing the manufacturing equipment cost of a semiconductor device and its manufacturing cost, in relation to the manufacturing method of the semiconductor device subjected to flip chip bonding.

CONSTITUTION: A board 37 where to an insulation bonding agent 38 is applied is precured at its semi-curing temperature, and mounting pads 37a of this board 37 are aligned with stud bumps 34 of a semiconductor chip 31, and further, their temporary fixing are so performed that the bumps 34 are pressed down against the pads 37a with a first pressing force. Then, a flip chip bonding is so performed that by a compression-heating head 42, the bumps 34 are pressed down against the pads 37a with a second pressing force larger than the first pressing force while the insulation bonding agent 38 is heated at its curing temperature.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 05.10.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 12.10.1999

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3030201

[Date of registration] 04.02.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 11-17852

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 10.11.1999

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-297227

(43) 公開日 平成7年(1995)11月10日

(51) Int.Cl.⁶

H 0 1 L 21/60

識別記号

3 1 1 S

庁内整理番号

6918-4M

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平6-88762

(22) 出願日 平成6年(1994)4月26日

(71) 出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72) 発明者 吉良 秀彦

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72) 発明者 藤井 昌直

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72) 発明者 石川 直樹

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74) 代理人 弁理士 伊東 忠彦

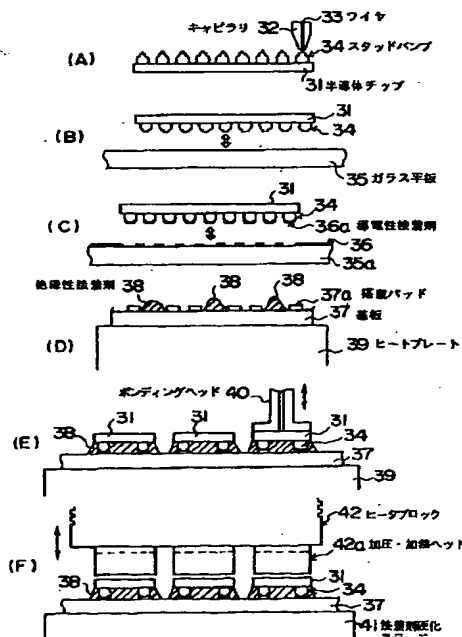
(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 本発明はフリップチップ接合される半導体装置の製造方法に関し、製造設備コスト及び製造コストの低減を図り、完全なフリップチップ接合を行うことを目的とする。

【構成】 絶縁性接着剤38が塗布された基板37を半硬化温度でプリキュアし、この基板37の搭載パッド37aに半導体チップ31のスタッドバンプ34をアライメントし第1の加圧力で押圧して仮固定を行う。そして、加圧・加熱ヘッド42aにより、絶縁性接着剤38を硬化させる温度で加熱しつつ第1の加圧力より高い第2の加圧力で押圧してフリップチップ接合を行う構成とする。

本発明の製造工程図である



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定数の半導体チップ(31)上にそれぞれ所定数の突起状電極(34)が形成されると共に、一方で基板(37)上における前記半導体チップ(31)の搭載部(37a)の領域に熱硬化性の絶縁性接着部材(38)を塗布する工程と、前記基板(37)上の前記絶縁性接着部材(38)を半硬化温度で加熱する工程と、前記基板(37)の搭載部(37a)に前記半導体チップ(31)をアライメントして第1の加圧力で第1の固定を行う工程と、前記半導体チップ(31)が固定された前記基板(37)を、前記絶縁性接着部材(38)の熱硬化温度で加熱すると共に、前記半導体チップ(31)を第2の加圧力により第2の固定を行う工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】 前記第1の加圧力を前記第2の加圧力より小とすることを特徴とする請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項3】 前記第2の加圧力により前記半導体チップ(31)ごとに同時に第2の固定を行うことを特徴とする請求項1又は2記載の半導体装置の製造方法。

【請求項4】 前記突起状電極(34)は、ワイヤボンディングにおけるスタッドにより所定数形成され、前記各スタッドの高さ合せが行われることを特徴とする請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項5】 前記突起状電極(34)上に導電性接着部材(36a)が形成されることを特徴とする請求項1又は4記載の半導体装置の製造方法。

【請求項6】 前記突起状電極(34)上の前記導電性接着部材(36a)は、平板(35)上にスキージングされた導電性接着部材(36)の転写により形成されることを特徴とする請求項5記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明はフリップチップ接合される半導体装置の製造方法に関する。

【0002】近年、半導体装置の高密度化が進むに伴って半導体チップの高密度実装を行うために、また高速動作の要求より配線長の短縮化を行うために、バンプによるフリップチップ接合が行われるようになってきている。このような半導体装置を製造するにあたり、低コスト化が望まれている。そのため、半導体チップの実装における高精度なアライメントを維持しつつ低コスト化を図る必要がある。

【0003】

【従来の技術】図5に、従来のフリップチップ方式の半導体装置の製造工程図を示す。図5(A)において、まず半導体チップ11のアルミニウムパッド11上にワイ

ヤボンディング技術により、ワイヤ(例えばアルミニウム、銅、金等)13を用いてスタッドバンプ(ボンディングボールのみ)14が所定数形成される。

【0004】この各スタッドバンプ14の高さは約20 μ m程度のばらつきがあり、図5(B)において半導体チップ11のスタッドバンプ14をガラス平板15に押し付けてレベリングを行い各スタッドバンプ14の高さを揃える。

【0005】続いて、図5(C)において、予めガラス平板15a(図5(B)のガラス平板15と同じものであってもよい)上に導電性接着剤16が薄くスキージングされており、この導電性接着剤16に各スタッドバンプ14を押しつけて付着させる転写が行われる。

【0006】一方、図5(D)に示すように、搭載される半導体チップ11のスタッドバンプ14の数に対応して搭載パッド17aが形成された基板17上に、スクリーン印刷法により補強用として熱硬化性の絶縁性接着剤18が塗布される。この基板17aの上方にボンディングヘッド(図示せず)で吸着された上記半導体チップ11が移送される。

【0007】そして、図5(E)において、基板17の搭載パッド17aと半導体チップ11のスタッドバンプ14とをアライメントし、ボンディングヘッドにより加圧、加熱して半導体チップ11を基板17にフリップチップ接合と実装を同時に行うものである。

【0008】この場合、ボンディングヘッドには熱源が具備されており、加熱により絶縁性接着剤18を熱硬化させてフリップチップ接合を補強している。

【0009】なお、加熱の方法としてボンディングヘッドの周辺に熱風を噴射するノズルを配置して、アライメントと加圧、加熱を同時に行うことも知られている(特開平5-67648号公報)。

【0010】他方、図示しないが、フリップチップ接合するにあたり、基板17の搭載パッド上に半導体チップのバンプをアライメントして加圧のみで搭載し、その後、搭載パッドとバンプに熱硬化性の絶縁性接着剤を塗布浸透させ、加熱ブロックや恒温槽等で加熱することにより絶縁性接着剤を硬化させることも知られている(特開平3-184352号公報)。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】しかし、図5(E)に示すように、搭載パッド17aとスタッドバンプ14をアライメントして加圧すると共に、絶縁性接着剤18を硬化させるために加熱している。すなわち、このような製造設備は高精度なアライメントが要求されると共に、加熱機構を具備しなければならず、設備がコスト高になり、コスト高の設備で絶縁性接着剤18への硬化(加熱)に時間を費やすことで実装コストが高くなるという問題がある。

【0012】また、特開平3-184352号公報に記

載されるように、加圧のみで半導体チップを搭載した後に加熱を行うことは、半導体チップと基板の熱膨張差（約4倍）によって変位を生じ、フリップチップ接合が不完全になるという問題がある。

【0013】そこで、本発明は上記課題に鑑みなされたもので、製造設備コスト及び製造コストの低減を図ると共に、完全なフリップチップ接合を行う半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。

【0014】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、請求項1では、所定数の半導体チップ上にそれぞれ所定数の突起状電極が形成されると共に、一方で基板上における前記半導体チップの搭載部の領域に熱硬化性の絶縁性接着部材を塗布する工程と、前記基板上の前記絶縁性接着部材を半硬化温度で加熱する工程と、前記基板の搭載部に前記半導体チップをアライメントして第1の加圧力で第1の固定を行う工程と、前記半導体チップが固定された前記基板を、前記絶縁性接着部材の熱硬化温度で加熱すると共に、前記半導体チップを第2の加圧力により第2の固定を行う工程と、を含む構成とする。

【0015】請求項2では、前記第1の加圧力を前記第2の加圧力より小とする。

【0016】請求項3では、前記第2の加圧力により前記半導体チップごとに同時に第2の固定を行う。

【0017】請求項4では、前記突起状電極は、ワイヤボンディングにおけるスタッドにより所定数形成され、前記各スタッドの高さ合せが行われる。

【0018】請求項5では、前記突起状電極上に導電性接着部材が形成される。

【0019】請求項6では、前記突起状電極上の前記導電性接着部材は、平板上にスキージングされた導電性接着部材の転写により形成される。

【0020】

【作用】上述のように、請求項1、4、5、6の発明では、突起状電極が形成された半導体チップを基板上にアライメントして加圧のみで第1の固定を行った後に加圧及び絶縁性接着剤を硬化させるための加熱を行うように第1の固定と加熱、加圧を別工程で行う。これにより、アライメント機構と加熱機構を別の設備とすることで製造設備コストが低減されると共に、最終の加圧、加熱時にはアライメントが終了していることから一括で処理が可能となり、スループットが向上し、製造コストの低減を図ることが可能となる。

【0021】この場合、第1の加圧力による第1の固定時に絶縁性接着剤を半硬化温度で加熱することにより、粘性やチクソ性が低下して第1の固定の密着力を向上させることが可能となる。

【0022】請求項2の発明では、第1の加圧力は第2の加圧力より小とする。これにより第1の加圧力による第1の固定時に突起状電極のつぶれ量のばらつきを吸収

することが可能となる。

【0023】請求項3の発明では、第2の加圧力による第2の固定を半導体チップごとに行わせる。これにより、マルチヘッド化が可能となって、実装作業性を向上させることが可能となる。

【0024】

【実施例】図1に、本発明の一実施例の全体構成図を示す。図1は、本発明の製造方法を実現するための製造システム21の全体ブロック図を示したものである。

【0025】図1に示す製造システム21において、22はチップローダであり、所定数の電極パッド（例えばアルミニウムパッド）が形成された半導体チップを供給する。23はボンダであり、ワイヤボンディング技術により半導体チップ上に突起状電極としてスタッドバンパを形成する。

【0026】24は転写装置であり、スタッドバンパ表面に導電性接着剤を転写する。25はキュア／アライメント・加圧装置であり、後述する基板を接着剤半硬化温度で加熱すると共に、ステッパにより該基板をスタッドバンパが形成された半導体チップをアライメントして第1の加圧力で第1の固定を行う。

【0027】一方、26は基板ローダであり、搭載部である搭載パッドが各半導体チップのスタッドバンパの数に対応して形成された基板を供給する。27は接着剤塗布装置であり、供給された基板の各半導体チップに対応する搭載パッドの領域にそれぞれに一定量の熱硬化性の絶縁性接着剤をディスペンサにより塗布してキュア／アライメント・加圧装置25に供給する。

【0028】28は、加圧・加熱装置であり、基板上に固定された半導体チップを第2の加圧力で加圧すると共に、絶縁性接着剤が硬化する温度で加圧して第2の固定を行う。29はアンローダであり、当該半導体チップが実装された基板を排出する。ここで、図2に本発明の製造説明図を示すと共に、図3に本発明の製造工程図を示す。まず、チップローダ22よりボンダ23に半導体チップ31が移送され、半導体チップ31に形成された電極パッド（図示せず）上にキャピラリ32よりワイヤ（例えばアルミニウムワイヤであり、電極パッドが銅又は金等の場合には、銅ワイヤ又は金ワイヤ）33から形成されるスタッドバンパ34をワイヤボンディング技術により所定数形成する（図2ステップ（S）1、図3（A））。このようにして半導体チップ21上のスタッドバンパ34は、高さ約20μmのばらつきを有することから、当該スタッドバンパ34をガラス平板35に押し付けてレベルングが行われ（図2（S）2、図3（B））、転写装置24に移送される。

【0029】転写装置24では、ガラス平板35a上に導電性接着剤36が薄くスキージされており、加熱しながらスタッドバンパ34を押し付けて当該スタッドバンパ34の表面に導電性接着剤36aが転写される（図2

(S)3, 図3(C))。なお、ガラス平板35aへの導電性接着剤36のスキージングは、スキージにより導電性接着剤36と接触するゴムでガラス平板35a上に押し出して行われるものである。

【0030】一方、基板ローダ26により搭載パッド37aが実装する半導体チップ31のスタッドバンプ34の数に対応して、該半導体チップ31ごとに形成された基板37が接着剤塗布装置27に供給され、熱硬化性の絶縁性接着剤38が半導体チップ31ごとの搭載パッド37aの各領域に塗布されている(図2(S)4)。そして、キュア/アライメント・加圧装置25のヒートプレート39上に移送される(図2(S)5, 図3(D))。

【0031】この基板37は、ヒートプレート39上で絶縁性接着剤38が半硬化する温度でプリキュアが行われる(図2(S)5)。このプリキュアにより、半導体チップ31を搭載した基板37を加圧・加熱装置28に移送させる際の振動等で位置ずれを生じないように絶縁性接着剤38を半硬化(粘度及びチクソ性を下げる)させて半導体チップ31の密着力を向上させるものである。

【0032】続いて、ボンディングヘッド40により半導体チップ31(図3(C))が吸着され、それぞれ基板37の各領域の搭載パッド37a上に、アライメントを行いつつボンディングヘッド40を第1の加圧力で押し付けて第1の固定として仮固定が行われる(図2(S)6, 図3(E))。この場合、基板37(絶縁性接着剤38)をヒートプレート39によりキュアが行われている。

【0033】総ての半導体チップ31が仮固定された基板37は、搬送レール等で加圧・加熱装置28に移送され、接着剤硬化ステージ41に載置される(図2(S)7)。この接着剤硬化ステージ41の上方には上下動自在のヒータブロック42が配置され、ヒータブロック42に個々に平行出し機能を有する加圧・加熱ヘッド42aが、各半導体チップ31ごと、又は所定数の半導体チップ群ごとに所定数備えられる。

【0034】そこで、ヒータブロック42の加熱による加圧・加熱ヘッド42aには絶縁性接着剤38が熱硬化する温度の熱が伝達されており、ヒータブロック42を下降させて加圧・加熱ヘッド42で各半導体チップ31を第2の加圧力により同時に押圧すると共に、加熱ヘッドにより絶縁性接着剤38を硬化させる第2の固定が行われる(図2(S)8, 図3(D))。

【0035】この場合、第2の加圧力は上述の第1の加圧力より大で設定される。これは押圧時のバンプ潰れ量のばらつきや基板37の搭載パッド37aの厚さばらつきを吸収させるためのものであると共に、加熱時の基板37と半導体チップ31の熱膨張の違いを吸収させるためのもので、完全なフリップチップを行うことができる

ものである。

【0036】そこで、図4に、本発明により製造されたマルチチップモジュールの半導体装置の外観図を示す。図4に示すように、半導体装置51は、基板37上に例えば5つの半導体チップ31がスタッドバンプ34によりフリップチップ接合されたマルチチップモジュールであり、熱硬化された絶縁性接着剤38により固定強化されたものである。

【0037】このように、アライメントを必要とする仮固定工程と加圧、加熱工程を別個としており、そのため、高精度なアライメントを行うキュア/アライメント・加圧装置25と加熱を行う加圧・加熱装置28とを別個の設備とすることにより、高額な加熱機構を備えるアライメント装置を不要とすることができ、製造設備コストを低減させることができる。

【0038】また、絶縁性接着剤38を硬化させるための加熱は行わずに、キュア/アライメント・加圧装置25で半導体チップ31をアライメントして搭載することから実装作業性がよく多数のチップ搭載を行うことができ、製造コストを低減させることができる。

【0039】さらに、加圧・加熱装置における加圧・加熱ヘッド42a(図3(D))を複数化することができ、実装作業性が向上して製造コストを低減させることができるものである。

【0040】

【発明の効果】以上のように、請求項1, 4, 5, 6の発明によれば、突起状電極が形成された半導体チップを基板上にアライメントして加圧のみで第1の固定を行った後に加圧及び絶縁性接着剤を硬化させるための加熱を行うように第1の固定と加熱、加圧を別工程で行うことにより、アライメント機構と加熱機構を別の設備とすることで製造設備コストが低減されると共に、最終の加圧、加熱時にはアライメント機構が終了していることから一括で処理が可能となり、スループットが向上し、製造コストの低減を図ることが可能となる。

【0041】請求項2の発明によれば、第1の加圧力は第2の加圧力より小とすることにより、第1の加圧力による第1の固定時に突起状電極のつぶれ量のばらつきを吸収することができる。

【0042】請求項3の発明によれば、第2の加圧力による第2の固定を半導体チップごとに行わせることにより、マルチヘッド化が可能となって、実装作業性を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の全体構成図である。

【図2】本発明の製造説明図である。

【図3】本発明の製造工程図である。

【図4】本発明により製造されたマルチチップモジュールの半導体装置の外観図である。

【図5】従来のフリップチップ方式の半導体装置の製造

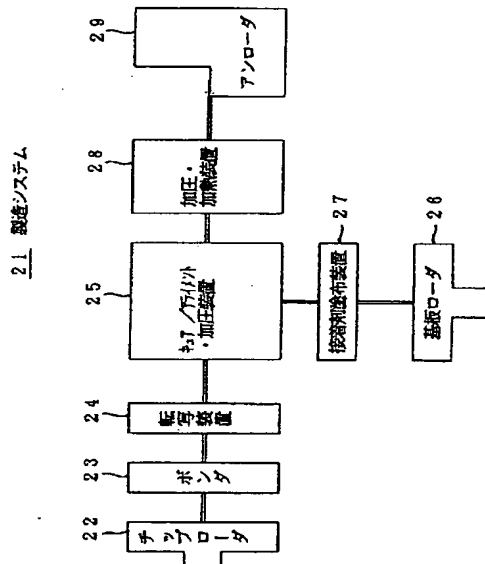
工程図である。

【 符号の説明 】

- 21 製造システム
- 22 チップローダ
- 23 ボンダ
- 24 転写装置
- 25 キュア／アライメント・加圧装置
- 26 基板ローダ
- 27 接着剤塗布装置
- 28 加圧・加熱装置
- 29 アンローダ
- 31 半導体チップ

【 図1 】

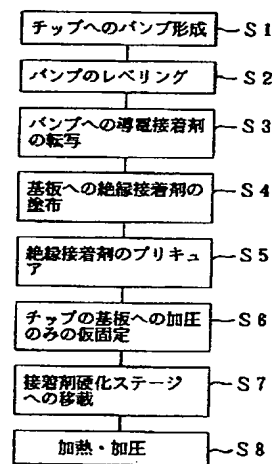
本発明の一実施例の全体構成図



- 34 スタッドバンブ
- 36, 36a 導電性接着剤
- 37 基板
- 37a 搭載パッド
- 38 絶縁性接着剤
- 39 ヒートプレート
- 40 ボンディングヘッド
- 41 接着剤硬化ステージ
- 42 ヒータブロック
- 10 42a 加圧・加熱ヘッド
- 51 半導体装置

【 図2 】

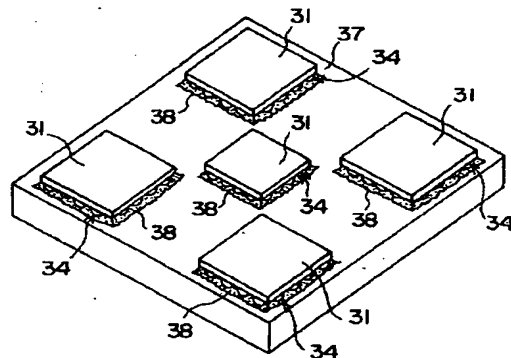
本発明の製造説明図



【 図4 】

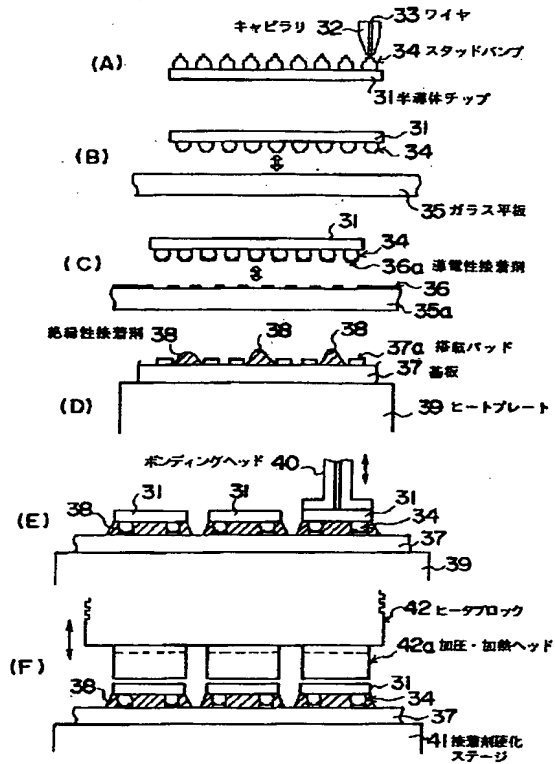
本発明により製造されたマルチチップモジュールの半導体装置の外観図

51 半導体装置



【 図3 】

本発明の製造工程図である



【 図5 】

従来のフリップチップ方式の半導体装置の製造工程図

